

Insert Paper Title Here (English)

홍길동¹, 김철수², John Smith^{2*}

¹국립강릉원주대학교 전자반도체공학부, 강릉, 대한민국

²Dept. of Electrical and Computer Engineering, Example Univ., USA

*Corresponding Author: email@example.com

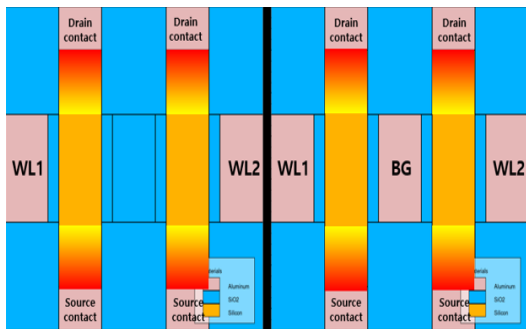
Abstract

이 문단에 초록(국문 또는 영문)을 입력하세요. 초록은 연구의 배경, 목적, 방법, 핵심 결과, 결론 및 의의를 간결하게 요약해야 합니다. 초록의 분량 제한은 없으나, 1쪽 내외로 작성하며, 필요 시 핵심 그림을 추가할 수 있습니다. 약어는 처음 등장 시 풀어 쓰고 괄호 내에 약어를 표기하십시오.

Enter your abstract text here (English). State the context and motivation, briefly describe the method or experimental setup, highlight key quantitative or qualitative results, and conclude with implications or future work. Keep the abstract concise and self-contained. Avoid undefined abbreviations.

(이하 여백)

Keywords: semiconductor devices; neuromorphic computing; gas sensor; thin film processing



[Fig. 1. Schematic diagram of vertical channel DRAM]

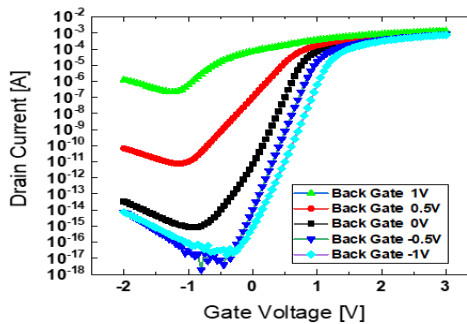


Fig. 2. Transfer characteristics for various back gate bias]

[선택] 연구비 지원 또는 감사 문구를 여기에 기재할 수 있습니다. / [Optional] Acknowledgment text here.

References

- [1] J. Doe et al., "Title of the journal article," IEEE Trans. Electron Devices, vol. 70, no. 5, pp. 1234-1240, 2024.
- [2] 홍길동 외, "반도체 소자 공정 연구," 전자공학회논문지, 45권 2호, 55-62쪽, 2023.
- [3] A. Author, B. Author, Semiconductor Device Fundamentals, 2nd ed., Springer, 2022.